

10A、45V肖特基整流管

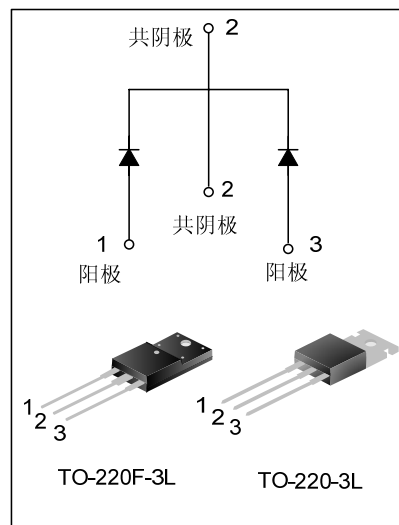
描述

SBD10C45T/F是采用硅外延工艺制作而成的肖特基整流二极管，保护环结构可以起到过压保护的作用，并且可以提高产品的可靠性。

产品广泛应用于开关电源、极性保护电路等各类电子线路中。

特点

- * 具有过压保护的保护环结构
- * 抗冲击能力强
- * 低功耗，高效率
- * 正向压降低
- * 结温可以到125°C



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装形式
SBD10C45T	TO-220-3L	SBD10C45T	无铅	料管
SBD10C45F	TO-220F-3L	SBD10C45F	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	额 定 值	单 位
最大反向峰值电压	V_{RRM}	45	V
正向平均整流电流	I_{FAV}	10	A
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	120	A
工作结温范围	T_J	-40~125	$^{\circ}\text{C}$
芯片存储温度范围	T_{STG}	-40~125	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参 数 名 称	符号	额 定 值	单 位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.0	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电参数规格(单管脚)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最 小 值	最 大 值	单 位
正向压降	V_F	$I_F=5\text{ A}; T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	0.65	V
	V_F	$I_F=5\text{ A}; T_J=125^{\circ}\text{C}$	--	0.57	V
反向漏电流	I_R	$V_R=45\text{ V}; T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	100	μA
	I_R	$V_R=45\text{ V}; T_J=125^{\circ}\text{C}$	--	15	mA

特性曲线

图1、正向压降典型值

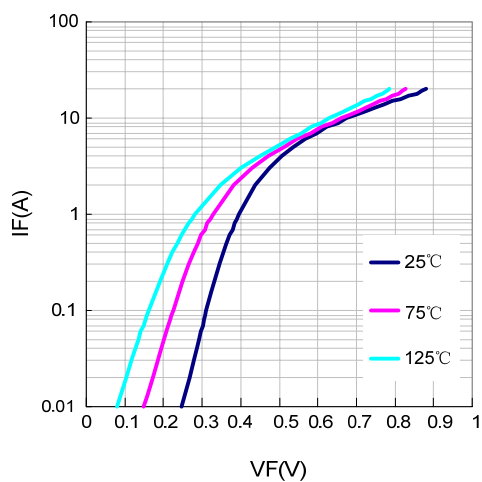


图2、反向漏电流典型值

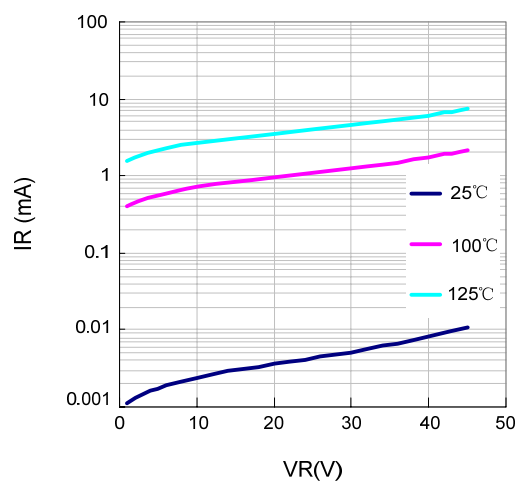
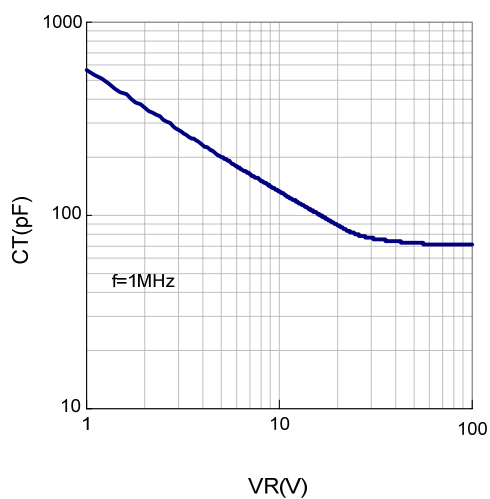


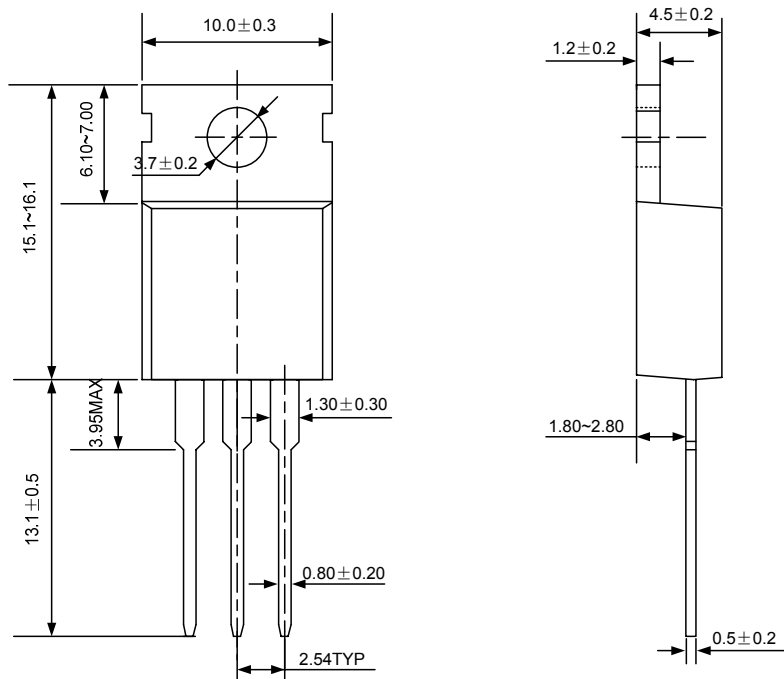
图3、结电容典型值



封装外形图

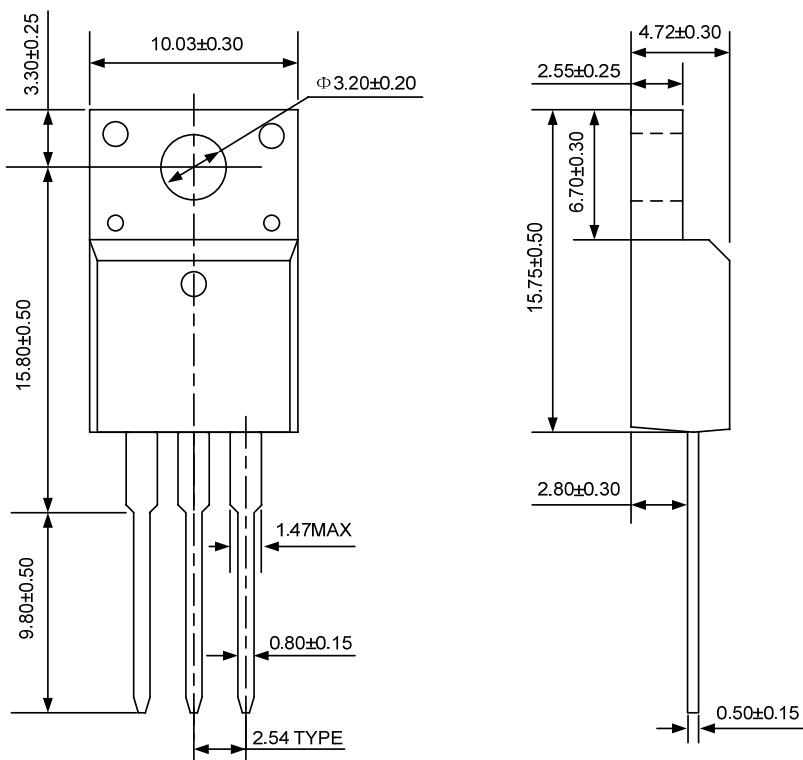
TO-220-3L

UNIT: mm



TO-220F-3L

UNIT: mm



声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 **Silan** 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附:

修改记录:

日期	版本号	描 述	页 码
2010.06.09	1.0	原版	
2010.10.22	1.1	修改说明书模板	
2011.09.01	1.2	修改“封装外形图”	
2012.03.28	1.3	修改“电参数规格”	